

InGaAs фотодетекторный чип 1310 нм, 5000 мкм — техническое описание

P/N : WIMA-5000

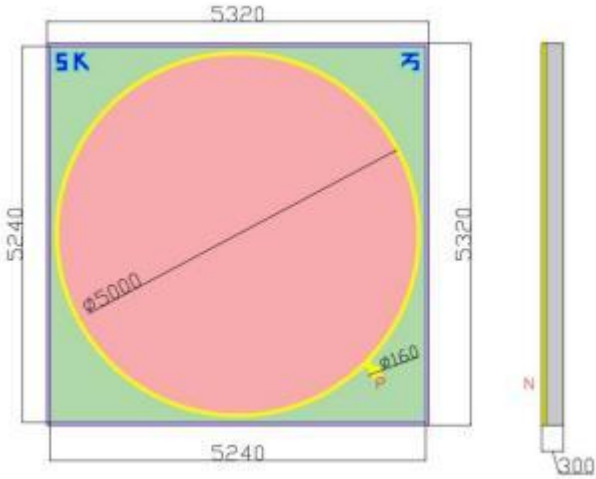
Применение

Оптические датчики; измерители
оптической мощности

Структура

InGaAs/InP PIN-чип; P-электрод (анод):
золото

N-электрод (катод): золото



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	-	5000	-	мкм
Ширина чипа	5190	5240	5290	мкм
Длина чипа	5190	5240	5290	мкм
Высота чипа	280	300	320	мкм
Размер контактной площадки	150	160	170	мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	Vr=-1V	-	55	225	нА
Емкость	Cp	Vr=-1V	-	3500	-	пФ
Напряжение обратного смещения	Vbr	Ir=-10μA	20	38	60	В
Чувствительность	R	@1310 nm	0.8	0.9	-	А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		900	1310	1600	нм

Примечание: ESD (HBM) > 800 В

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА